

檔 號：

保存年限：

教育部 函

機關地址：100217 臺北市中正區中山南路5
號

承辦人：翁如慧

電話：(02)7712-9111

電子信箱：juhuiw@mail.moe.gov.tw

受文者：國立成功大學

發文日期：中華民國113年4月25日

發文字號：臺教資(二)字第1132701553號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：先進製程IC設計及驗證環境建置計畫申請作業說明、113年度環境建置計畫書
(附件一 A09000000E_1132701553_senddoc3_Attach1.pdf、附件二
A09000000E_1132701553_senddoc3_Attach2.pdf)

主旨：檢送本部113年度「先進製程IC設計及驗證環境建置計畫
申請作業說明」，請查照。

說明：

- 一、依據本部補助推動人文及科技教育先導型計畫要點辦理。
- 二、本計畫旨為為深化我國大學電機、電子、資工等電資領域系所前瞻晶片設計與布局技術培育量能，投入發展先進IC設計與布局課程、師資等教研資源，建置16nm以下前瞻半導體製程(FinFET)設計及驗證環境，提升師生具備前瞻晶片設計、前瞻布局技術與下線製作能力，以培育國內半導體產業所需高階技術人才，鞏固我國半導體領先地位。
- 三、申請方式：免備文，請於113年6月7日前至本部計畫申請系統(<https://cfp.moe.gov.tw/Login/MOELogin.aspx>)，完成線上申請及用印後計畫書電子檔上傳作業，逾期未完成線上申請及計畫書電子檔上傳者，不予受理。(洽詢電話：(02)3366-1918，先進製程IC設計人才培育先期規劃辦公室康小姐)。
- 四、本申請作業說明及相關附件(含計畫申請書格式)可於本部



網站（首頁/認識教育部/本部各單位/資訊及科技教育
司 / 電 子 布 告 欄 ） 或 本 計 畫 網 站
<https://moeisoc.web2.ncku.edu.tw/> 下載。

正本：國立臺灣大學、國立成功大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立中山大學、國立中正大學、國立中央大學、國立中興大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立雲林科技大學

副本：國立臺灣大學電子工程學研究所(先進製程IC設計人才培育先期規劃辦公室)(含附件)

113/04/25
14:55:54

裝

訂

線